

导航



讲学图片1



🏠 首页

正文字体:大 中 小

## 国家技术发明一等奖获得者江风益教授为我校“新世纪论坛”讲学

2016-04-29 10:03:40 74 👤 0 👍

4月27日上午，国家技术发明一等奖获得者、南昌大学副校长、国家硅基LED工程技术研究中心主任江风益教授应邀在华南师范大学“新世纪论坛”作学术讲座。

江风益教授以“硅衬底发光二极管技术创新之回顾”为题，概述了发光二极管的特征和发展历程，着重阐述了第三代氮化物半导体发光二极管在研制和产业过程中面临的问题和机遇，对中国在氮化物发光二极管技术领域从跟踪走向创新进行了分析。江风益教授随后对其领导的科研团队如何克服硅衬底制备氮化物二极管遇到的诸多问题进行了深入阐述，对硅衬底制备氮化物发光二极管面临的大晶格应力失配、金属镓回溶、量子阱应力调控、光输出和提取的问题进行了深入探讨。最后对硅衬底发光二极管，以及硅衬底氮化物材料和器件的发展趋势进行了分析，并就如何开展实验科学研究提出了自己的看法。讲座结束后，江风益教授热情地回答了师生们提出的各种问题，并就氮化物材料和器件今后的重点研究方向进行了探讨，受到了与会师生的一致好评。

报告会由光电子材料与技术研究所副所长李述体研究员主持，光电子材料与技术研究所、信息光电子科技学院、华南先进光电子研究院师生100多人参加了报告会。

江风益教授，1963年生，2015年国家技术发明一等奖获得者，南昌大学副校长、国家硅基LED工程技术研究中心主任、国家863计划半导体照明工程重大专项专家组副组长、科技部半导体照明技术创新团队带头人、教育部半导体照明技术创新团队带头人、中组部、中宣部、人事部和科技部联合授予全国杰出专业技术人才称号。江风益教授先后从事过10余种半导体发光材料与器件的研究开发工作，主持并完成了国家863计划重大专项、电子发展基金项目、江西省重点重大科技项目等20余项项目。代表性成果为“硅衬底氮化镓基LED材料生长与芯片制造技术”，在第一代半导体硅材料上，成功地制备了高质量的第三代半导体GaN材料，成功研制硅衬底垂直结构的GaN蓝光/绿光LED芯片，并在国际上率先实现了这一新技术产品的批量生产。这一技术使国家在半导体照明技术领域从跟踪走向了跨越，2015年，硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管技术获得国家技术发明奖中唯一一等奖。江风益教授授权发明专利40多项。发表SCI/EI论文50余篇，SCI他引400多次。

作者/通讯员:戚明月 | 来源:科技处 光电子材料与技术研究所 | 编辑:杨柳青

## 推荐



- ▶ 我校在全国“挑战杯”竞赛中斩获6奖
- ▶ 《光明日报》刊发陈金龙教授论党内政治文化理论文章
- ▶ 《南方都市报》：陈金龙：“教师的教学要能让学生 ‘解渴’ ”
- ▶ 陈长琦：以学术为生命

▶ 金羊网：广东取材、韶关拍摄、华师班底.....这部电影题材很罕见

## 排行



- ▶ 文汇报：史家的足迹——关文发先生学术生平
- ▶ 关文发教授的学术人生
- ▶ 我校女子篮球队勇夺2016年广东省大学生篮球联赛冠军
- ▶ 华师男足勇夺2016-2017年中国大学生五人制足球联赛（广东赛区）亚军
- ▶ 张恒亮：不允许自己不努力

## 影像



一夜春雨遍地金黄，最美华师惊艳了广州城！



“你的名字是？” “华师。”

版权所有：华南师范大学党委宣传部 华南师范大学新闻中心

Copyright © 2001-2016 news.scnu.edu.cn. All rights reserved.

技术支持：广州可媒

☎ 电话：(020)85211027

✉ 电邮：xiaobao@m.scnu.edu.cn

☁ 累积访问量：27145326

👆 今日访问量：24084